

ТУ 11-04
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
К1055КТ1АПКБ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
АДБК.431160.969 ТУ
(Введены впервые)
Срок действия с 23.08.2004 г.

выписка

2004

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микросхемы интегральные типа К1055КТ1АПКБ (далее микросхемы), используемые в качестве токового ключа с пороговым управлением, изготавливаемые для народного хозяйства и для поставки на экспорт.

Микросхемы, выпускаемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 18725 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящих ТУ.

Микросхемы изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Термины и определения – по ГОСТ 17021, ГОСТ 19480.

Ссылочные нормативные документы приведены в разделе 10.

1.2 Условное обозначение

1.2.1 Условное обозначение микросхем – по ОСТ 11 073.915.

1.2.2 Тип поставляемых микросхем указан в таблице 1.

1.2.3 Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема К1055КТ1АПКБ АДБК.431160.969 ТУ.

Таблица 1 – Типы поставляемых микросхем

Условное обозначение микросхемы	Основное функциональное назначение	Основные параметры в нормальных климатических условиях	Обозначение комплекта конструкторской документации	Обозначение электрической схемы	Условное обозначение корпуса по ГОСТ 18472	Количество элементов в электрической схеме
	Остаточное напряжение открытого тока	Ток утечки закрытого ключа	I _D , мА	U _L = 4,0 В U _S = 30 В		
K1055KT1АПКБ	Токовый ключ с пороговым управлением	не более	10	ЮФ3.439.004	ЮФ3.439.004 Э3	KT-26

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Требования к конструкции

2.1.1 Микросхемы изготавливаются по комплекту конструкторской документации, обозначение которого приведено в таблице 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем приведены на чертеже ЮФ3.439.004 ГЧ.

Микросхемы предназначены для автоматизированной сборки (монтажа) аппаратуры и соответствуют требованиям конструктивно-технологической группы VIII исполнения 4 ГОСТ 20.39.405, а также для ручной сборки (монтажа), что указывают в договоре на поставку.

2.1.2 Обозначение описания образцов внешнего вида ЮФ3.365.075 Д.

2.1.3 Масса микросхемы не более 0,3 г.

2.1.4 Величина растягивающей силы не более 5 Н (0,5 кгс).

Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

2.1.5 Температура пайки (235 ± 5) °C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 5 мм, длительность пайки ($2 \pm 0,5$) с.

Микросхемы должны выдерживать воздействие тепла, возникающего при температуре пайки (260 ± 5) °C.

2.1.6 Электрическая схема с назначением и нумерацией выводов приведена на чертеже, обозначение которого указано в таблице 1.

2.1.7 Микросхемы должны быть трудногорючими.

Стойкость к воздействию аварийных электрических перегрузок гарантируется построением электрических узлов микросхемы.

2.2 Требования к электрическим параметрам и режимам

2.2.1 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

2.2.2 Электрические параметры микросхем в течение наработки в пределах времени, равного сроку сохраняемости, должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

2.2.3 Электрические параметры микросхем в течение срока сохраняемости приведены в таблице 2.

2.2.4 Значение предельно допустимых электрических режимов эксплуатации в диапазоне температур среды приведены в таблице 3.

2.3 Требования к устойчивости при механических воздействиях

Механические воздействия по ГОСТ 18725 , в том числе:

линейное ускорение 5000 м/с^2 (500 g).

2.4 Требования к устойчивости при климатических воздействиях

Климатические воздействия по ГОСТ 18725 , в том числе:

пониженная рабочая температура среды минус $60 ^\circ\text{C}$;

повышенная рабочая температура среды $85 ^\circ\text{C}$;

повышенная предельная температуры среды $85 ^\circ\text{C}$;

изменение температуры среды от минус 60 до $85 ^\circ\text{C}$.

2.5 Требования к надежности

2.5.1 Наработка микросхем 50000 ч., а в следующих облегченных режимах $U_S = 20 \text{ В}$, $U_I = 20 \text{ В}$, $I_S = 30 \text{ мА} - 60000 \text{ ч.}$

2.5.2 Интенсивность отказов транзисторов в течение наработки не более 10^{-6} 1/ч.

2.5.3 Гамма – процентный срок сохраняемости 10 лет.

2.6 Требования по стойкости к воздействию очищающих растворителей

2.6.1 Микросхемы должны быть устойчивы к воздействию спирто-бензиновой смеси 1:1.

Таблица 2 – Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозна- чение	Норма		Темпе- ратура, °C
		не менее	не более	
Остаточное напряжение открытого ключа ($I_S = 20 \text{ мА}$, $U_{IH} = 8 \text{ В}$), В	U_{DS}		0,5	25 ± 10 -60 ± 3 85 ± 3
Ток утечки закрытого ключа ($U_{IL} = 4 \text{ В}$, $U_S = 30 \text{ В}$), мкА	I_{LD}		10	25 ± 10 -60 ± 3 85 ± 3

Таблица 3 – Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации в диапазоне температур среды

Наименование параметра, (условия), единица измерения	Буквенное обозна- чение	Норма		При- мечা- ние
		не менее	не более	
Коммутируемое напряжение ключа, В	U_S	0	30	
Входное напряжение ключа, В	U_I	0	35	
Коммутируемый ток ключа, мА	I_S	-	50	
Рассеиваемая мощность при температуре ок- ружающей среды от минус 60 до 35 °C, мВт	P_{tot}	-	500	
Тепловое сопротивление кристалл – среда, °C/Вт	R_{thja}	-	250	
Температура перехода (кристалла), °C	T_j	-60	150	
Примечание - В диапазоне температур окружающей среды от 35 до 85°C мощность снижается линейно по формуле: $P_{tot\ max} = (150 - T_{amb}) / R_{thja}$				

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указания по применению и эксплуатации микросхем – по ГОСТ 18725.

5.2 Допустимое значение статического потенциала 500 В.

5.3 Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °С продолжительностью не более 4 с.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки (по длине вывода) не менее 5 мм.

Число допустимых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более 3-х.

Режим и условия монтажа в аппаратуре микросхем – по ОСТ 11 073.063.

5.4 При монтаже в аппаратуре допускается одноразовый изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса под углом 90 ° с радиусом закругления не менее 1,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус.

Изгиб в плоскости выводов не допускается.

5.5 При эксплуатации не допускается подача на вход и выход микросхемы напряжений обратной полярности.

I_I , mA

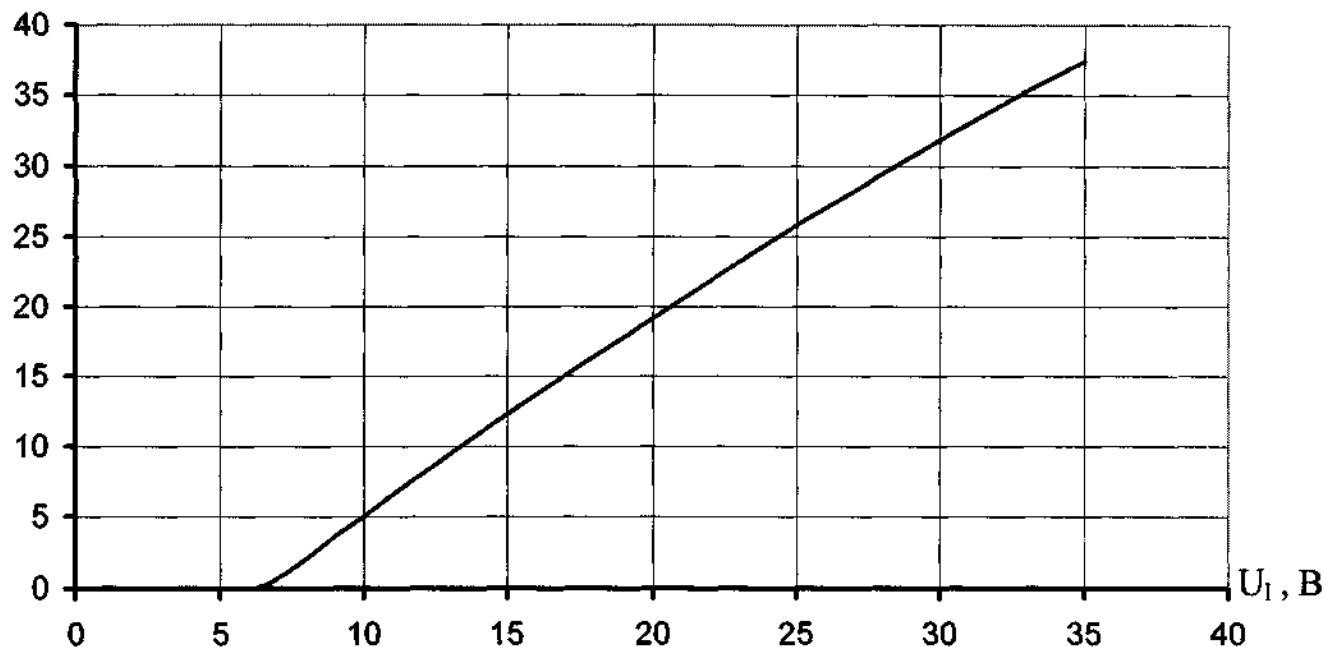


Рисунок Б.1- Типовая зависимость входного тока I_I от входного напряжения U_I

U_{DS} , В

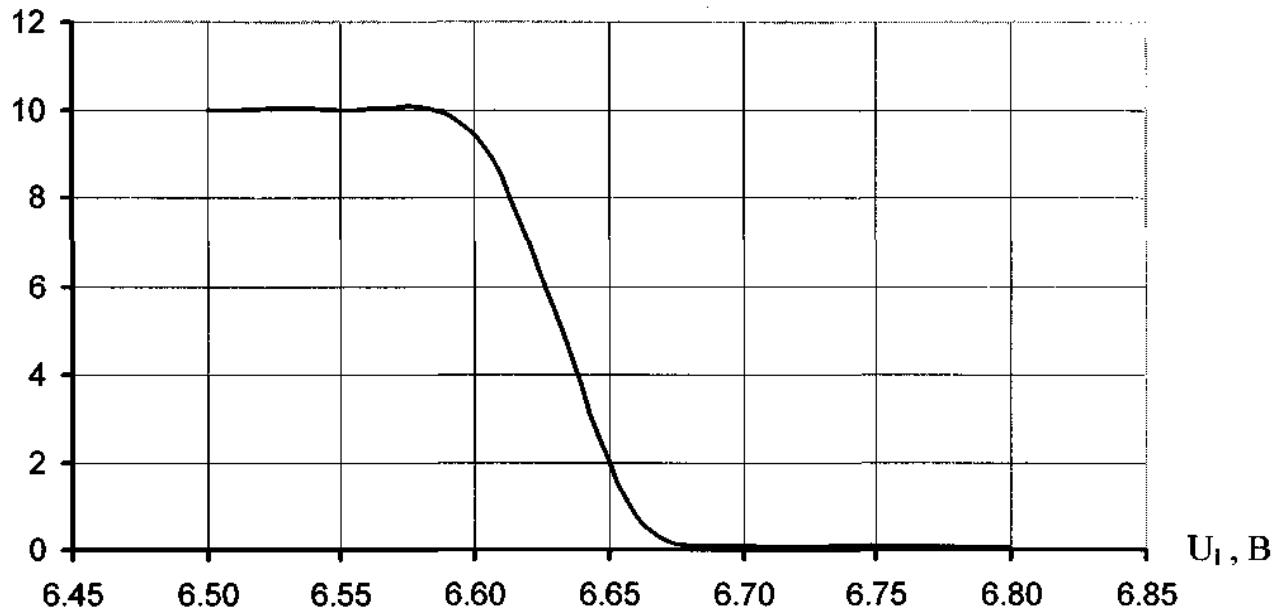


Рисунок Б.2 - Типовая зависимость остаточного напряжения открытого ключа U_{DS} от входного напряжения U_I

U_{DS} , мВ

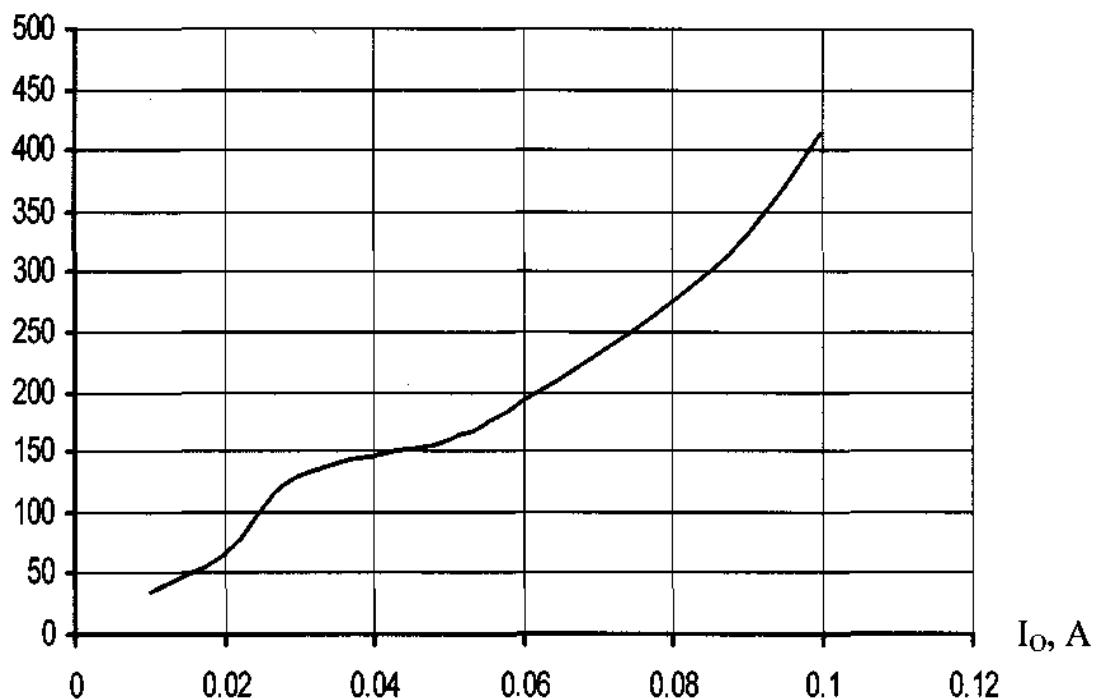


Рисунок Б.3 - Типовая зависимость остаточного напряжения открытого ключа U_{DS} от выходного тока I_O при $U_{IH} = 8$ В